N⁺ 离子束注入诱变选育桑黄菌株的研究

全卫丰,汪 洁,刘广建,薛 璟 (江苏省苏微微生物研究有限公司,江苏无锡 214063)

摘要 [目的]研究 N* 离子注入诱变选育桑黄菌株,提高桑黄菌的产量。[方法]通过对 N* 离子注入诱变后桑黄孢子的存活率以及实 变率的研究确定离子注入的最适剂量,诱变后用拮抗试验结合酯酶同工酶酶谱分析验证菌株发生突变,之后分别以菌丝形态,菌丝生长 速度、液体发酵菌丝体生物量以及液体发酵胞外多糖产量为参数进行变异菌株的筛选。[结果] 确定了离子注入诱变桑黄适宜参数:注 入剂量 2.00×10¹⁶ions/cm²,注入能量 20 KeV。得到 1 株高产桑黄菌株 PI 126,其生物量和多糖产量分别为 23.7 和 7.6 g/L,比出发菌株 相应产量显著提高。经平板传代,10 代后变异菌株的遗传性状较稳定,无明显回复突变。[结论]低能离子束注入技术用于桑黄育种是

关键词 离子注入;桑黄;育种

中图分类号 S567 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2013)01-00107-03

Study on Breeding Phellinus igniarius by N⁺ Implantation

QUAN Wei-feng et al (Jiangsu Suwei Microorganism Research Limited Company, Wuxi, Jiangsu 214063)

Abstract [Objective] To breed Phellinus igniarius and improved P. igniarius yield by N* implantation. [Method] The optimum dosage of ion implantation was obtained through research on survival rate and mutation rate of P. igniarius spore after induction of N⁺ implantation. After mutation, antagonistic test combined with analysis of esterase isozymes to verify strain mutation, with mycelial morphology, growth rate, liquid fermentation mycelial biomass and extracellular polysaccharide yield as parameters to screen variant strain. [Result] The appropriate parameters of the ion implantation mutagenesis P. igniarius were determined; implantation dosage 2.00 × 10¹⁶ ions/cm², injection energy 20 KeV. A high-yielding strain of P. igniarius called PI 126 was obtained, whose biomass and polysaccharide production are 23.7 g/L and 7.6 g/L respectively, and the mutant genetic traits are stable after ten generation. [Conclusion] Low energy ion beam implantation is feasible for breeding of P. igniarius.

Key words Ion implantation: *Phellinus igniarius*: Breeding

桑黄[Phellinus igniarius(L. ex. Fr)Quel],学名:鲍氏层 孔菌,属于担子菌亚门层菌纲多孔菌目多孔菌科针层孔菌属 类真菌[1]。桑黄具有抗菌、抗癌、抗纤维化、抗氧化以及免疫 调节等多种药理作用[2],尤其是其抗癌作用。桑黄是目前国 际公认的生物抗癌物质中有效率最高的药用真菌(其对小鼠 肉瘤 S180 的抑制率为 96.7%) [3]。桑黄胞外多糖(PIEP)是 桑黄中的主要功能性成分之一,具有明显的抗肿瘤活性和抗 脂质讨氧化作用[4]。

离子束注入技术是近年来发展起来的一类新型诱变育 种手段,具有变异幅度大、突变率较高、突变谱较广、突变体 的遗传性能较稳定、回复突变率低等优点,目前在微生物以 及作物育种中得到成功应用^[5]。为此,笔者对 N⁺离子注入 诱变选育桑黄菌株进行了研究,旨在为提高桑黄菌产量提供 理论依据。

材料与方法

1.1 材料

- 1.1.1 试验菌株。桑黄菌株1株(保藏号:52363)购自中国 农业科学院。
- 1.1.2 培养基。PDA 固体培养基: 马铃薯汁 200.0 g(煮沸 后纱布过滤去汁),葡萄糖 20.0 g, MgSO₄ 0.5 g, KH, PO₄1.0 g,琼脂20.0 g,水1 L,pH 自然。种子培养基和发酵培养基: 马铃薯汁200.0 g(煮沸后纱布过滤去汁),葡萄糖20.0 g, MgSO₄ 0.5 g,KH,PO₄ 1.0 g,水 1.0 L,pH 自然。
- 1.1.3 主要仪器。DYCZ30型电泳仪,北京市六一仪器厂 生产;回转式摇床,上海跃进医疗器械厂生产;722N型可见

全卫丰(1978-),男,江苏无锡人,助理研究员,从事食药用 作者简介

菌菌种选育研究,E-mail:qwfwxjs@163.com。 收稿日期 2012-09-17

分光光度计,上海精密科学仪器有限公司生产;LZD-900 型离 子注入机。

方法 1.2

- 1.2.1 低能 N⁺离子注入诱变。
- 1.2.1.1 注入前处理。取 0.02 g 桑黄孢子粉,用 5.0 ml 5% 氯胺 T 溶液浸泡 5 min, 4 000 r/min 离心 5 min, 无菌水洗 涤、离心,重复3次,加水定容至10.0 ml。无菌水稀释,配制 成浓度为10⁴ 个/ml 级的孢子悬液。取0.1 ml 均匀涂布无菌 平皿中央,置于超净台由无菌风吹干,经镜检孢子无重叠后 立即进行低能 N⁺离子注入。
- 1.2.1.2 N⁺离子注入。离子注入前开机预热 2 h, 紫外线 对靶室持续消毒30 min,调节靶室真空度为1×10⁻³ Pa,注入 物质 N^+ 离子提前加速到 20 KeV,然后以 2×10^{15} ions/(cm² · s)的脉冲率对样品进行剂量为 25 × 10¹⁴、50 × $10^{14}, 100 \times 10^{14}, 150 \times 10^{14}, 200 \times 10^{14}, 250 \times 10^{14}, 300 \times 10^{14}$ ions/cm²的注入。试验组采用间歇式脉冲注入,连续注入5 s 后间隔 15 s,对照组置于靶室真空中,不经离子注入。
- 1.2.1.3 离子注入后孢子存活量统计。离子注入后,用1.0 ml 无菌水洗脱培养皿内孢子,取 0.1 ml 洗脱液均匀涂布于 PDA 平面固体培养基上,28 ℃避光培养 72 h 后孢子萌发形 成菌落,计数。对照组做相同处理。绘制存活率曲线。
- 1.2.2 N⁺离子注入对菌株突变率的影响。以供试桑黄菌 株作为对照,对接受离子注入诱变后形成的菌落进行液体发 酵,每个剂量随机挑取20个菌株,28℃培养6d后考察菌株 的生物量。生物量高于对照5%以上的为正突变,低于对照 5%以上的为负突变,否则为无义突变。
- 1.2.3 诱变菌株的筛选。

1.2.3.1 初筛。挑取菌丝浓密、生长健壮的菌落,培养后镜检观察锁状联合,同时与出发菌株进行拮抗试验和酯酶同工酶试验^[6],观察拮抗试验现象,计算酶谱相似度(T)和联合系数(S)^[7]。拮抗试验呈显阳性(表现为隆起型、隔离型、沟型)时认定为发生突变,反之舍弃。

1.2.3.2 复筛。

- (1)菌丝生长速度比较试验。将确定发生突变的菌株进行生长速度试验,用打孔器取直径相同的圆形菌块,接种于PDA培养基中央,观察菌丝萌发时间,记录和测定菌丝生长速度,剔除生长速度小于对照组生长速度50%的菌株。
- (2) 菌株液体发酵生物量比较。菌株接种于种子培养液中,旋转式摇床 140 r/min、28 ℃避光培养 7 d 左右,以 5% 的接种量接种于 100 ml 发酵培养基中,相同条件下培养 3 ~ 4 d,4 000 r/min 离心 15 min,收集菌丝体,烘干至恒重,称量。
- (3) 胞外多糖含量测定。取 1.0 ml 发酵上清液,加 4.0 ml 无水乙醇,充分振荡后放入 4 $^{\circ}$ 冰箱中过夜。采用蔥酮 硫酸法测定桑黄多糖含量 $^{[8]}$ 。
- 1.2.4 遗传稳定性试验。将筛选出的高产菌株传代培养 10 代后按照"1.2.3.2"的方法进行试验,测定其菌丝生长速度、 生物量、多糖产量等指标,选取各项指标无明显退化的菌株。

2 结果与分析

- 2.1 N⁺注入对桑黄孢子存活量的影响 离子注入的质量 沉积、电荷交换效应、效应能量沉积效应在不同阶段所起的 作用不同^[9]。注入剂量在 1.25 × 10¹⁶ ions/cm² 以下时,桑黄 孢子的存活率随着注入剂量的增大而迅速减小,这可能是因 为离子束注入剂量较小时,能量沉积效应起主要作用,导致 DNA 链断裂和细胞膜过氧化反应,动量传递通过细胞表面的 溅射与刻蚀,对细胞壁、细胞膜进行修饰致使其细胞损伤、突 变、死亡,使得生物体 DNA 损伤造成成活率下降。离子束注 入剂量中等或适宜时,大量离子的库仑斥力形成保护屏障, 可排斥一定剂量离子注入;同时堆积的电荷形成弱电场,可 激活生物体内各种酶和诱导修复机制的启动,对生物体具有 保护作用,有可能使生物体产生有利于生长发育的变化,提 高成活率 $^{[10]}$ 。该试验中,在剂量为 2.00×10^{16} ions/cm 2 时成 活率达到相应的小峰值。当离子束注入剂量进一步提高,电 荷的大量堆积达到一定临界值后,将会导致库仑保护屏障崩 溃,对离子注入具有保护作用的屏障消失,离子辐射的损伤 超过生物体的修复能力,致使孢子存活率又迅速下降接近全 部死亡。
- 2.2 N⁺ 离子注入对菌株突变率的影响 由图 2 可知,桑黄菌株的突变率随着 N⁺ 离子注入剂量的增大而呈上升趋势,剂量达到 2.50×10¹⁶ ions/cm² 时突变率达到最大值,而后又略微下降,这可能是因为在该剂量范围内,染色体在库仑保护屏障的作用下进行不完全损伤修复,导致 DNA 发生较高概率的突变^[10]。注入剂量在 2.00×10¹⁶ ~ 2.50×10¹⁶ ions/cm²时,菌株突变率高于 50%,诱变效率较高。桑黄菌株的正突变率随着注入剂量的增加而先上升后下降,在注入剂量为 2.00×10¹⁶ ions/cm² 时达到峰值(23.43%),正突变

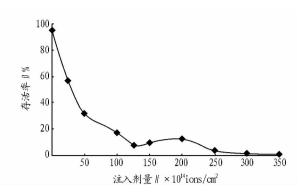


图1 桑黄孢子在不同 N^* 离子注入剂量下的存活率曲线 效率最高。在注入剂量为 2.00×10^{16} ions/cm² 时,菌株的突 变率和正突变率均较高,所以选定该剂量作为诱变的适宜 剂量。

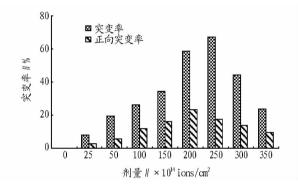


图 2 不同 N⁺ 离子注入剂量对菌株突变率的影响

2.3 初筛和复筛结果 弃去生长速度小于对照组 50%、菌 丝稀疏的菌株,得到 25 株菌株,较对照组生长速度快的菌株 有 10 株,分别为 PI 105、PI 113、PI 126、PI 106、PI 135、PI 129、 PI 107、PI 121、PI 130 和 PI 108,其中除 PI 107 号菌株外,其 他菌株菌丝均鲜黄且健壮,满板时间较短(表 1)。

表 1 生长速度试验结果

编号	菌丝生长速度//mm/d	菌丝长势	
PI 105	6.50 ± 0.01 aA	+ + +	
PI 113	$6.50 \pm 0.02 \text{ aA}$	+ +	
PI 126	6.50 ± 0.01 aA	+ + +	
PI 106	6.50 ± 0.03 aA	+ + +	
PI 135	$6.38 \pm 0.02 \text{ aA}$	+ + +	
PI 129	$6.38 \pm 0.01 \text{ aA}$	+ + +	
PI 107	$6.35 \pm 0.03 \text{ bAB}$	+	
PI 121	$6.35 \pm 0.01 \text{ bAB}$	+ +	
PI 130	$6.32 \pm 0.03 \text{ bAB}$	+ + +	
PI 108	$6.31 \pm 0.02 \text{ bB}$	+ + +	
CK	6.16 ± 0.02	+ +	

注:数据为平均值和标准差(n=5)。同列数据后不同大、小写字母分别表示在0.01、0.05 水平差异显著;+++表示菌丝长势旺盛,鲜黄浓密;++表示菌丝鲜黄细密;+表示菌丝黄褐色稀疏。

对所得菌株进行液体发酵试验。由表 2 可知,液体发酵生物量及多糖产量均显著高于对照组的菌株有 3 株,分别为 PI 113、PI 106 和 PI 126。综合菌株的生长速度、菌丝在 PDA 固体培养基的生长情况以及液体发酵生物量和多糖含量等情况,最终筛选得到菌株 PI 106 和 PI 126。

表 2 菌株液体发酵试验结果

g/L

编号	生物量	胞外多糖产量	
PI 105	24.6 ±0.3 aA	4.2 ± 0.3 bAB	
PI 113	$23.7 \pm 0.2 \text{ aA}$	$7.5 \pm 0.2 \text{ aA}$	
PI 126	$23.7 \pm 0.1 \text{ aA}$	$7.6 \pm 0.1 \text{ aA}$	
PI 106	$21.6 \pm 0.2 \text{ aA}$	$6.5 \pm 0.1 \text{ aA}$	
PI 135	$20.7 \pm 0.1 \text{ aB}$	$7.0 \pm 0.2 \text{ aA}$	
PI 129	$14.1 \pm 0.3 \text{ aA}$	$4.2 \pm 0.3 \text{ aB}$	
PI 107	$13.8 \pm 0.3 \text{ aAB}$	$4.5 \pm 0.3 \text{ aAB}$	
PI 121	$12.0 \pm 0.2 \text{ bB}$	$3.8 \pm 0.2 \text{ bB}$	
PI 130	$11.8 \pm 0.1 \text{ bB}$	$3.5 \pm 0.1 \text{ bB}$	
CK	12.1 ± 0.1	3.8 ± 0.1	

注:数据为平均值和标准差(n=3);同列数据后不同大、小写字母分别表示在0.01、0.05 水平差异显著。

2.4 遗传稳定性试验结果 由表 3 可见,新菌株 PI 106 和 PI 126 在传代至第 5、10 代后,以液体发酵生物量、多糖产量等参数均未出现显著降低,遗传性状稳定,而 PI 126 的各项试验参数均优于 PI 106。

表3 遗传稳定性试验结果(n=3)

g/L

菌株	生物量			多糖产量		
	第1代	第5代	第10代	第1代	第5代	第10代
PI 106	21.6	21.3	21.4	6.5	6.5	6.6
PI 126	23.7	23.6	23.4	7.6	7.0	7.1

3 讨论

离子東注入诱变具有质量、能量双重诱变效应的特征,不同于射线辐射,离子注入引发的生物效应既有能量沉积和动量传递,又有元素质量沉积,注入离子的不同电荷数、质量数、能量、剂量组合提供了众多诱变条件,通过这种电、能、质的联合作用,强烈影响生物细胞的生理生化特性,以引起基因突变,所以变异幅度大,有较高的突变率和较广的突变谱,突变体的遗传性能较稳定,回复突变率低。

该研究通过离子束注入诱变选育液体发酵生物量和多糖含量高的新菌株获得了成功,试验也证实运用 N⁺ 离子注入诱变桑黄等真菌是切实可行的。桑黄菌丝性状以及液体发酵生物量与桑黄子实体产量高低之间可能存在一定的正向相关性,但该种相关性需要进一步的试验证实,因此,桑黄新菌株子实体栽培产量以及商品性状等需要进一步试验。

参考文献

- [1] 陈士瑜,陈惠. 菇菌栽培手册[K]. 北京;科学技术出版社,2003;270 271.
- [2] 周村山,马海乐. 桑黄及其药理作用研究进展[J]. 食用菌,2003(2):50-51.
- [3] IKEKAWA T, NAKANISHI M, UEHARA N, et al. Antitumor action of some basidiomycetes, especially phellinus linteus[J]. Gann, 1968, 59:155 – 157.
- [4] 郑立军,沈业寿,季俊虬,等 桑黄胞外多糖药理活性的初步研究[J]. 食品科学,2007,28(1):318-321.
- [5] 吴丽芳,李红,余增亮. 离子束在生命科学中的应用[J]. 激光生物学报,1999,8(4):298 304.
- [6] 黄晨阳,张金霞,陈强,等. 食用菌菌种真实性鉴定酯酶同工酶电泳法(NY/T1097-2006)[S]. 北京:中国农业出版社,2006.
- [7] 林兴生,李开本,陈体强,等. 11 个灵芝菌株的栽培性状和酯酶同工酶研究[J]. 江西农业大学学报,2001,23(1):80-84.
- [8] 中华人民共和国药典委员会. 中华人民共和国药典(第1部)[S]. 北京:电子工业出版社,2005:130.
- [9] 宋道军,姚建铭,邵春林,等. 离子注人微生物产生马鞍型存活曲线的可能作用机制[J]. 核技术,1999,22(3):130-132.
- [10] LI S C, YAO J M, YU Z L. Studies on mutation breeding of high-yielding xylanase strainsby low energy ion beam implantation [J]. Plasma Scienceand Technology, 2007, 9(2):248-251.
- [11] LIU G J, MENG Y T, YANG S L, et al. Screening of biocontrol strain Bacillus subtilis by N, ion beam implantation [J]. Agricultural Science & Technology, 2012, 13(8); 1658 1663.
- [12] 孙国琴,邢丽萍,王玉芬,等. 离子束注人技术在食用菌育种上的应用进展[J]. 内蒙古农业科技,2011(3):103-104,112.
- [13] 王创云,王陆军,秦作霞,等.N~,离子束注人玉米自交系变异的生物学效应与分子标记分析[J].华北农学报,2011(5);131-134.
- [14] 孙鸿举,刘倩,张娜、低能离子注入对仙客来幼苗生长发育的影响 [J]. 内蒙古农业科技,2011(6):26-29.

(上接第106页)

分(茎叶、果实)质量分数和地下部分(根)质量分数的比值。 富集系数用来衡量植株对生产环境中某种元素的吸收富集 能力。转运系数用来衡量植株对生产环境中某种元素的迁 移转运能力。由表3可知,紫茎泽兰对 Mg、Ni、Pb 有较强的 富集能力,根部的富集系数都大于1,但是茎叶对这3种元素 的富集系数均小,使得其转运系数较小。紫茎泽兰对 Cr 的 富集系数、转运系数均大于1,可以用于煤渣污染土壤重金属 Cr 的修复治理。

表 3 富集系数和转运系数

系数	部位	Mg	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Pb
富集系数	根	3.432	0.960	0.439	0.151	2. 137	0.605	1.376
	茎	1.525	1.445	0.132	0.033	0.138	0.645	0.225
	叶	2.317	1.037	0.244	0.017	0.128	0.372	0.209
转运系数		0.538	1.333	0.403	0.178	0.063	0.884	0.159

3 讨论

煤渣污染可以造成土壤中多种重金属含量超标。植物 修复技术是治理重金属污染的重要手段。该研究检测了煤 渣污染土壤中重金属含量,进一步研究了紫茎泽兰对受污染土壤重金属的富集、修复特性。结果表明,受煤渣污染土壤中重金属含量大小顺序为 Fe>Mg>Cu>Ni>Cr>Mn>Ni,其中 Cr污染达到Ⅱ级标准。紫茎泽兰对多种重金属有一定的耐受性,能够在较高浓度的重金属污染土壤上生长,而且对多种重金属有一定的富集作用,特别是对 Mg、Cr、Ni、Pb的富集系数均大于1,对 Cr的转运系数为1.333,可以作为煤渣污染土壤 Cr的修复植物。

参考文献

- [1] 王凯荣,张玉烛,胡荣贵. 不同改良剂对降低重金属污染土壤上水道糙米铅镉含量的作用[J]. 农业环境科学学报,2007,26(2):476-481.
- [2] 赵文霞,冯辉. 粉煤灰中重金属元素分布规律的研究[J]. 粉煤灰综合 利用,2002(2):38-39.
- [3] 刘莉,杨尽,苏小丽. 粉煤灰在土壤改良中机理研究[J]. 安徽农业科学,2010,38(31):166-167,179.
- [4] 鲁平,桑卫国,马克平.外来人侵种紫茎泽兰研究进展与展望[J]. 植物 生态学报,2005,29(6):1029-1037.
- [5] 李雪瑶,应浩. 紫荆泽兰的危害、防治及综合利用[J]. 生物质化学工程,2009,43(1):57-60.
- [6] 国家环境保护局南京环境科学研究所. 中华人民共和国国家标准. 土壤环境质量标准(GB15618-1995)[S]. 北京:中国标准出版社,2006.